

(19)



Евразийское  
патентное  
ведомство

(21)

201992821

(13)

А3

## (12) ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ

(43) Дата публикации заявки

2020.11.30

Дата публикации отчета

2021.03.31

(22) Дата подачи заявки

2014.09.24

(51) Int. Cl. G21B 1/05 (2006.01)

G21B 1/15 (2006.01)

H05H 1/10 (2006.01)

---

### (54) СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ КОНФИГУРАЦИИ С ОБРАЩЕННЫМ ПОЛЕМ

---

(31) 61/881,874; 62/001,583

(32) 2013.09.24; 2014.05.21

(33) US

(62) 201690643; 2014.09.24

(88) 2021.03.31

(71) Заявитель:

ТАЭ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК. (US)

(72) Изобретатель:

Тушевски Михель, Биндербаэр

Михль, Барнз Дэн, Гарате Эусебиу, Го

Хоуян (US), Путвински Сергей (FR),

Смирнов Артем (US)

(74) Представитель:

Медведев В.Н. (RU)

(57) Предложенная высокоэффективная конфигурация с обращенным полем (FRC) включает в себя центральную емкость для удержания, две диаметрально противоположные формирующие секции тета-пинчей с обращенным полем, связанные с упомянутой емкостью, и две камеры диверторов, связанные с формирующими секциями. Магнитная система включает в себя катушки квазипостоянного тока, расположенные аксиально вдоль компонентов FRC-системы, зеркальные катушки квазипостоянного тока между камерой удержания и формирующими секциями, и зеркальные пробки между формирующими секциями и диверторами. Формирующие секции включают в себя модульные формирующие системы импульсного питания, позволяющие осуществлять статическое и динамическое формирование, а также ускорение FRC. FRC-система дополнительно включает в себя инжекторы пучков нейтральных атомов, инжекторы таблеток, системы геттерирования, осевые плазменные пушки и электроды, смещающие поверхности потока. Инжекторы пучков предпочтительно наклонены к средней плоскости камеры. В процессе работы параметры FRC-плазмы, включая термическую энергию плазмы, общие количества частиц, радиус и захватываемый магнитный поток, поддерживаются на или примерно на постоянном значении без спада во время инжекции пучков нейтральных частиц.

A3

201992821

201992821

A3

# ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ

(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:

201992821

## A. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

G21B 1/05 (2006.01)

G21B 1/15 (2006.01)

H05H 1/10 (2006.01)

Согласно Международной патентной классификации (МПК)

## Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:

Просмотренная документация (система классификации и индексы МПК)

G21B H05H

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)  
ЕАПАТИС, Google Patents, easpacenet

## В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	WO 2013/074666A 2 (THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 23.05.2013 [0036]-[0048]	1-26
A	TUSZEWSKI et al., "Combined FRC and Mirror Plasma Studies in the C-2 Device." TRANSACTIONS OF FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY VOL. 59 JAN. 2011 (01.2011), pg 23-25	1-26

последующие документы указаны в продолжении  
графы В

\* Особые категории ссылочных документов:

«A» - документ, определяющий общий уровень техники

«D» - документ, приведенный в евразийской заявке

«E» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи евразийской заявки или после нее

«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.

«P» - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки, но после даты испрашиваемого приоритета»

«T» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения

«X» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности

«Y» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий изобретательский уровень в сочетании с другими документами той же категории

«&» - документ, являющийся патентом-аналогом

«L» - документ, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: 18/01/2021

Уполномоченное лицо:

Заместитель начальника отдела механики,  
физики и электротехники



Д.Ф. Крылов